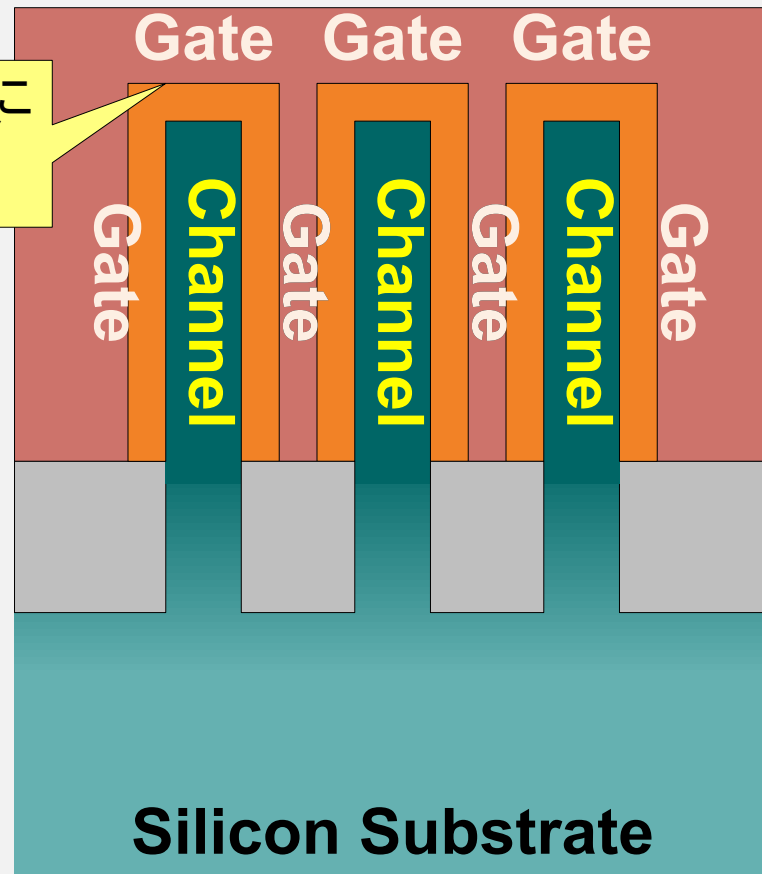


# FinFETとNanosheetのトランジスタ断面図

## FinFET Multi-Channel

フィンを複数にすることでゲート幅を広げ、駆動能力を増やす



Rotate 90°

チャンネルを横に寝かせる

## Nanosheet

フットプリントに対してチャンネル幅が広がる

チャンネルがゲートで囲まれたGAA(Gate All Around)になる

チャンネル幅に対してばらつきが減る

電力/パフォーマンスのチューニングの幅が広がる

